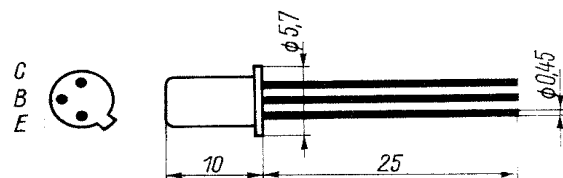


Germanium-pnp-Hochfrequenztransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für ZF-Verstärker in AM-Empfängern.



Masse ca. 0,4 g

Wärmewiderstand  $R_{thja} \leq 0,5 \text{ grad/mW}$

**Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich**

Kollektor-Basis-Spannung	$-U_{CBO}$	$= 15 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{EBO}$	$= 10 \text{ V}$
Kollektorstrom	$-I_C$	$= 15 \text{ mA}$
Emitterstrom	$I_E$	$= 15 \text{ mA}$
Basisstrom	$-I_B$	$= 5 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_j$	$= 75 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebstemperaturbereich		$-25 \text{ }^\circ\text{C bis } +65 \text{ }^\circ\text{C}$

**Statische Kennwerte**

		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$1,5 \mu\text{A}$	$10 \mu\text{A}$
$-U_{CB} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Basis-Reststrom	$-I_{CBO}$		$50 \mu\text{A}$	$500 \mu\text{A}$
$-U_{CB} = 15 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CEO}$		$85 \mu\text{A}$	$600 \mu\text{A}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
Kollektor-Emitter-Reststrom	$-I_{CES}$			$25 \mu\text{A}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$				
Emitter-Basis-Reststrom	$-I_{EBO}$			$500 \mu\text{A}$
$-U_{EB} = 10 \text{ V}$				

**Dynamische Kennwerte**

Grenzfrequenz	$f_{h21b}$	$3 \text{ MHz}$	$5 \text{ MHz}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$			
$-I_C = 1 \text{ mA}$			
$f = 3 \text{ MHz}$			
Kurzschlußstromverstärkung	$h_{12e}$	$20$	
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$			
$-I_C = 2 \text{ mA}$			
$f = 1 \text{ kHz}$			
Rauschmaß	F	$6 \text{ dB}$	$15 \text{ dB}$
$-U_{CE} = 6 \text{ V}$			
$-I_C = 0,5 \text{ mA}$			
$f = 0,5 \text{ MHz}$			
$R_g = 1 \text{ k}\Omega$			
Vierpolparameter	$g_{11e}$	$0,5 \text{ mS}$	$1,4 \text{ mS}$
	$C_{11e}$	$300 \text{ pF}$	$1 \text{ nF}$
	$-g_{12e}$	$3 \mu\text{S}$	$7 \mu\text{S}$
	$-C_{12e}$	$7 \text{ pF}$	$14 \text{ pF}$
	$ y_{21e} $	$13 \text{ mS}$	$17,5 \text{ mS}$
	$g_{22e}$	$30 \mu\text{S}$	$50 \mu\text{S}$
	$C_{22e}$	$25 \text{ pF}$	$50 \text{ pF}$

Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GF 100